PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-125227

(43) Date of publication of application: 17.05.1996

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number : 06-282565

(71)Applicant: SHICHIZUN DENSHI:KK

(22)Date of filing:

21.10.1994

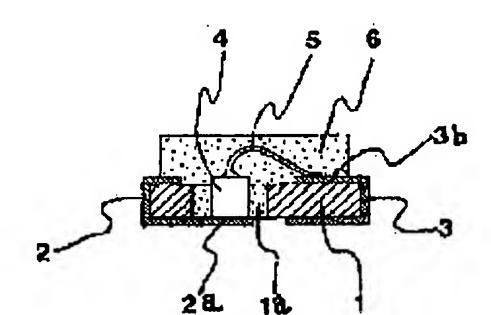
(72)Inventor: ONIKIRI AKIRA

FUKAZAWA KOICHI

(54) LIGHT EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide further thinner light emitting diode in relation to a chip type light emitting diode. CONSTITUTION: A larger hole 1a than an LED element is provided on almost central part of an insulating substrate 1 so as to form an electrode 2 comprising a metallic pattern by plating-wiring step to cover the aperture part below the hole 1a. Next, a light emitting diode element 4 is packaged on a part 2a of the electrode 2 inside this hole 1a so that the light emitting diode element may be connected to the other electrode 3 by a metallic fine wire 5 to be sealed with a translucent resin 6.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of

17.09.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3302203

[Date of registration]

26.04.2002

[Number of appeal against examiner's decision

[Date of requesting appeal against examiner's

2001-018546

of rejection]

16.10.2001

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

7

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-125227

(43)公開日 平成8年(1996)5月17日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

N

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

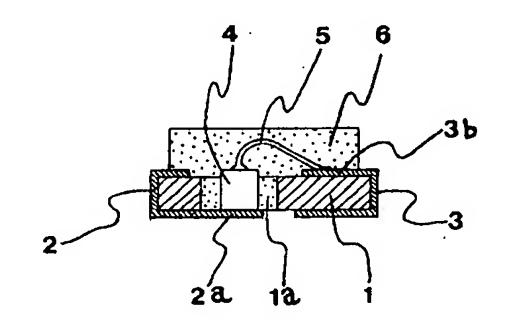
(21)出顧番号	特顧平6-282565	(71)出額人	000131430
			株式会社シチズン電子
(22) 出顧日	平成6年(1994)10月21日		山梨県富士吉田市上暮地1丁目23番1号
		(72)発明者	鬼切。彰
			山梨県富士吉田市上暮地1丁目23番1号
			株式会社シチズン電子内
		(72)発明者	深澤 孝一
			山梨県富士吉田市上暮地1丁目23番1号
			株式会社シチズン電子内
		(7.4) (A.DH 1	弁理士 川井 興二郎

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード

(57)【要約】

【目的】 チップ型発光ダイオードに関し、さらに薄型 の発光ダイオードを提供することを目的とする。

【構成】 絶縁基板1の略中央部分にLED素子よりも大きい穴1 a を設け、穴の下方の開口部をふさぐようにメッキ配線による金属パターンからなる電極2を形成する。この穴1 a 内の電極2の一部2 a 上に発光ダイオード素子4を実装し、該発光ダイオード素子と他方の電極3とを金属細線5で接続し透光性樹脂6にて封止する。



【特許請求の範囲】

絶縁基板上に一対の電極を形成し、該一 【請求項1】 対の電極の一方に発光ダイオード素子を実装し、該一対 の電極の他方と金属細線にてワイヤーボンディング接続 され、該発光ダイオード素子と該金属細線を覆うように 透光性樹脂にて封止したチップ型発光ダイオードにおい て、絶縁基板に発光ダイオード素子より大きい貫通穴も しくは溝等からなる収納部を設け、該収納部の一方の開 口部内に前記一対の電極の少なくとも一方が形成され、 該電極上に発光ダイオード素子が、一個または複数個実 10 装されたことを特徴とする発光ダイオード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チップ型の発光ダイオ ード(以下「LED」と略称する)に関するものであ り、特に軽薄短小を追求する電子機器向けに提供される 小型、薄型LEDに関する。

[0002]

【従来の技術】軽薄短小を追求する電子機器向けに提供 される小型、薄型LEDの代表的な従来構造を図3及び 20 図4に示す。図3のLEDは、略直方体形状を成した絶 縁基板1の表面にメッキ配線による金属パターンからな る一対の電極2、3を形成している。この電極は、絶縁 基板1の下面から側面を通り上面までコの字状を成し、 該電極2と3が対向するように形成されている。LED 素子4は該電極2上の上面電極部2bに実装され、電極 3上の上面電極部3bと金属細線5によりワイヤーボン デイング接続し、透光性樹脂6にてLED素子4と金属 細線5を覆う形で封止した構造を有している。図4のし EDは、細長い板状の一対の金属電極7、8を所定の間 30 隔をあけて配置し、該金属電極7の上面側部7bにLE D素子4を実装し、該金属電極8の上面側部8bと金属 細線5によりワイヤーボンディング接続し、透光性樹脂 6にて該金属電極7、8の一部とLED素子4と金属細 線5を含む周囲全体を封止した構造を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記従来技 術における各構造で、より薄型化を追求していった場 合、次のような欠点がある。図3の構造においては、べ ースになる絶縁基板1の厚みがLEDの総厚に加わって 40 くるため、薄型化を追求する場合この絶縁基板1の厚み を薄くする必要がある。ところが、LEDの機械的、及 び熱的信頼性を考慮した場合、薄くするのにも限界があ り、LEDの薄型化の妨げになっていた。次に図4の構 造においてであるが、本構造の場合図3の絶縁基板1に 相当するものは構成要素にない。絶縁基板は、LED素 子を実装するための一対の電極を保持し、機械的、及び 熱的な安定を保たせる目的を有している。図4の構造に おいては、この絶縁基板が無いために、電極7、8の上 方向と下方向に各々樹脂6が回り込むように形成し、電 50 れた穴1aに落とし込む形で、電極2の下面部2aに銀

極の保持、安定を図らなければならない。特に、電極 7、8の下方向の樹脂の一部6aが電極の保持、安定に 重要な役割を果たしているわけだが、本構造の場合、こ の樹脂の一部6aがLEDの薄型化の妨げになってい た。

【0004】本発明は、上記課題を解決せんとするもの であり、必要とされる性能、及び機械的、熱的信頼性を 具備しながら、さらに薄型のLEDを提供することを目 的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のLEDは、前記 課題を解決するために、絶縁基板上に一対の電極を形成 し、該一対の電極の一方にLED素子を実装し、該一対 の電極の他方と金属細線によりワイヤーボンディング接 続され、該LED素子と該金属細線を覆うように透光性 樹脂にて封止したチップLEDにおいて、LED素子を 実装する部分の絶縁基板に、LED素子より大きい貫通 穴、または溝等からなる収納部を設け、該収納部の一方 の開口部内に前記一対の電極の少なくとも一方が形成さ れ、該電極上にLED案子が、一個または複数個実装さ れた構造を有している。

[0006]

【作用】本発明のLEDは、LED素子が、絶縁基板に 設けられたLED素子より大きい穴からなる収納部の一 方の開口部内に形成された電極上に実装されているた め、絶縁基板の厚みがLEDの総厚に影響を与えなくな り、従来技術を用いた図3のLEDよりも、絶縁基板の 厚み分だけ薄型化を実現することが可能になる。又、従 来技術を用いた図4のLEDと比較した場合、本発明の LEDは穴をあけているとは言え、LED素子を実装す るための、一対の電極を保持し機械的、及び熱的な安定 を保たせるに十分な絶縁基板を具備している。したがっ て、図4のように透光性樹脂を、LED素子を実装する ための一対の電極の下方向まで形成させる必要が無く、 これと比較しても、より薄型化を可能にしている。

[0007]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の一実施例を説 明する。図1は本発明の一実施例を表す斜視図、図2は その中央断面図を表す。図1及び図2において、1は略 直方体形状を成した絶縁基板であり、この絶縁基板1の 略中央付近にLED素子の大きさより大きい、丸状の穴 1 a からなる収納部が形成されている。さらに、絶縁基 板1の表面にメッキ配線による金属パターンからなる一 対の電極2、3が形成される。電極2、3はいずれも、 絶縁基板1の下面から側面を通り上面までコの字状を成 し、電極2と3が対向するように形成されている。又、 電極2は絶縁基板1にあけられた丸状の穴1aを下面側 からふさぐように図中下方の開口部内にも突出して形成 されている。LED素子4は、この絶縁基板1に形成さ

3

Ź

ペースト等の導電性接着剤を用いて接着実装される。実装されたLED素子4はもう一方の電極3の上面部3bと金属細線5でワイヤーボンディング接続される。透光性樹脂6はLED素子4と金属細線5を覆う形で、絶縁基板1の上面上にのみ形成されている。この時、絶縁基板1の厚みをLED素子4の厚みと同じか、それ以下に設定することにより、LEDとしての総厚に絶縁基板1の厚みを考慮する必要が無くなり、より薄型のLEDが実現できることになる。尚、絶縁基板1に設ける穴1aは本実施例のような丸状だけでなく、楕円状または多角状等であってもよい。

【0008】図5に本発明の他の実施例に係るLEDの 斜視図、図6にその中央断面図を示す。本実施例の場合、絶縁基板1の表面に形成された一対の電極2、3 は、絶縁基板1の下面側及び穴1aの図中下方の開口部 内に突出するようにしか形成されておらず、側面及び上 面には形成されていない。また、これにともない、LE D素子4とワイヤーボンディング接続されるもう一方の 電極3の接続場所が前記実施例の時と異なり、穴1a内 の電極3の下面部3aに接続されている。この場合、絶 20 縁基板1に形成する穴1aを前記実施例と比較し、より 大きくする必要があるが、絶縁基板1表面のメッキ配線 からなる金属パターンが下面側片側のみですむため、製 造コストを下げることが可能となり、薄型でなおかつ安 価なLEDの提供が可能となる。

【0009】図7に本発明のさらに他の実施例に係るL EDの斜視図を示す。本実施例の場合、絶縁基板1に設けられている穴が、絶縁基板1の一辺から対向する他の一辺まで溝状に形成されており、該溝が絶縁基板1を二分する形になっている。本発明において絶縁基板に設け 30られる穴は、四方を絶縁基板に囲まれた完全な穴だけでなく、このように二辺を解放した溝であっても良い。

尚、本実施例における電極2、3は、二分された絶縁基*

* 板1の間に掛け渡されるように形成されている。

【0010】図8に本発明のさらに他の実施例に係るLEDの斜視図を示す。本実施例の場合、絶縁基板1に設けられている穴1a内にLED案子が2個実装されている。このように穴1a内に実装されるLED素子の数は一個のみならず、複数個であっても良い。

[0011]

【発明の効果】以上のように、本発明のLEDは、絶縁 基板に穴又は溝等からなる収納部を設け、その穴または 溝等の中にLED素子を実装することにより、LEDの 総厚に対して絶縁基板の厚みを考慮する必要が無くな り、LEDに要求される性能、及び機械的、熱的信頼性 を損なうことなく、薄型のLEDを提供することを可能 にするものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るLEDを示す斜視図。

【図2】図1に示すLEDの中央断面図。

【図3】従来のLEDを示す斜視図。

【図4】従来のLEDを示す斜視図。

【図5】本発明の他の実施例に係るLEDを示す斜視図。

【図6】図5に示すLEDの中央断面図。

【図7】本発明のさらに他の実施例に係るLEDを示す 斜視図。

【図8】本発明のさらに他の実施例に係るLEDを示す 斜視図。

【符号の説明】

絶縁基板

2、3 電極

4 LED素子

5 金属細線

6 透光性樹脂

7、8 金属電極

